

XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE'2013, Ryn 16-20 kwietnia 2013 r

Sensorowe właściwości warstw C-Pd wytwarzanych metoda PVD/CVD

E.Kowalska¹, M.Kozłowski¹, A.Kamińska¹, J.Radomska¹, H.Wronka¹, E.Czerwosz¹, K.Sobczak²

¹ Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

² Instytut Fizyki PAN, al.Lotników 32/46, 02-668 Warszawa



WPROWADZENIE

W ostatnich latach wodór brany jest pod wagę jako potencjalny nośnik energii, który może zastąpić paliwa kopalne. Poza tym wodór jest wykorzystywany w ogniwach paliwowych do przekształcenia energii chemicznej w elektryczną, gdzie produktem końcowym jest woda. Jeżeli technologie wodorowe będą rozwijane w przyszłości konieczne będzie zastosowanie sensorów wodoru o wysokiej czułości, szybkim czasie odpowiedzi oraz krótkim czasie regeneracji.

Obecnie w detekcji wodoru powszechnie stosowane są sensory palladowe zawierające nanostruktury typu nanocząstki, nanodruty lub nanorurki.

W pracy przedstawiamy badania sensorowych właściwości warstw C-Pd mierzone w obecności 1%H₂/N₂. Warstwy C-Pd zostały otrzymane metodą fizycznego odparowania w próżni prekursorów warstw (metoda PVD Physical Vapor Deposition) oraz chemicznego osadzania z par (metoda CVD - Chemical Vapor Deposition).
Głównym celem pracy było pokazania jak zmiany obserwowane w strukturze, topografii i morfologii warstw C-Pd w wyniku procesu CVD wpływają na ich właściwości sensorowe, zwłaszcza na czułość warstwy i szybkość jej odpowiedzi.

BADANIA TEM

Z przeprowadzonych badań TEM dla warstw CVD otrzymanych w temp. 500, 550, 600, 650, 700 i 750°C wyznaczono wykładniczą zależność pomiędzy średnią wielkością nanoziarna Pd a temperaturą procesu CVD. Najmniejsze ziarna o wielkości ~7-10 nm obserwowano w warstwach poddawanych modyfikacji w ~500 i 550°C. W wyższych temp. (od 600 do 750°C) średni rozmiar nanoziaren Pd wzrastał w zakresie temp. od 13 do 32 nm. Jednak w tych próbkach obserwowano wokół ziaren Pd otoczki grafitowe o różnych średnicach. Wydaje się, że te grafitowe otoczki mogą być odpowiedzialne za gorszą czułość warstw modyfikowanych w temp wyższych





Wykładnicza zależność pomiędzy średnim rozmiarem nanoziarna Pd a temp. procesu CVD

Wraz ze wzrostem temperatury procesu CVD rośnie średnia wielkość ziarna Pd Krzywa została wyznaczona z obrazowania TEM oraz z wykonanych histogramów.

Dla każdej próbki wyznaczono średnice dla minimum 100 nanozjaren.

1									
	Temp CVD	$\Delta R/R_0$	t ₉₀	Badania SEM					
	[°C]	[%]	[s]	SE	10 000x	LABE 10 000x	SE	50 000x	
	500	8,84	89	S. S.					Warstwa zawiera upakowane ziar rozmiarach od 5 głownie widoczn podłoża
	550	7,92	97	Ý					Na powierzchni są bardzo drobne 8nm) w miarę rów na powierzchni. węglowej jest n stosunku do wa PVD
	600	0,23	159	5				~~	Tylko w nieliczny zauważyć ziarna matrycy węglow chropowate.
	650	0,13	33		Q				W niektórych widoczne są w ziaren matr Nanoziarna Pd nm widoczne sa matrycy węglowe
	700	-	-					S.	Obrazowanie po procesu CVD węglowe tworz powierzchni pró są mało widoczn
	750	0,3	68	R					Matryca w przekształceniu, spłaszczone, n rozmiarach 20-3 sposób równom próbki.

powierzchni gęsto Pd o różnych 5nm Ziarna te sa a granicy ziarer

Struktura matrycy z pr

ch obszarach można Pd, natomiast ziarna vej stają się mnie

obszarach próbki yspy zbudowane z ycy węglowej. o rozmiarach ~18 ą pod powierzchnią

do próbi C). Zia upiska

Pomiary dyfrakcyjne z zastosowaniem techniki pomia vej GIXD dla warstwy CVD modyfikowanej w procesie o temp 500 °C

METODA SYNTEZY Proces PVD - I etap

W I etapie do wytworzenia wyjściowej warstwy węglowo-palladowej (C-Pd) stosowano metodę fizycznego odparowania w próźni (PVD) prekursorów warstwy tzn. fullerenu C₆₀ i octanu palladu PdC₂O₄. Oba związki odparowywano z dwóch oddzielnych źródeł na podłoża alundowe Al2O3 w czasie 10 minut. Odległość podłoży od źródeł wynosiła 54 mm, zaś prąd płynący przez źródło C_{60} wynosił 1, 9 A a prąd płynący przez źródło zwiazku palladu 1,3 A



Obraz SEM warstwy PVD

Na powierzchni warstwy widoczne są gęsto upakowane ziarna węglowe o rozmiarach 100-200nm. Nie obserwowano nanoziaren Pd. Obecność ziaren Pd w warstwie została erdzona w badaniach TEM

a) Elektronogram z warstwy PVD; b) obraz TEM tej warstwy wykonany techniką jasnego pola oraz c) wybrany fragment z zaznaczonymi plaszczyznami pochodzącymi od krystalitów Pd



METODA SYNTEZY Proces CVD - II etap

W II etapie warstwa wyjściowa poddawana była modyfikacji w różnych temperaturach stosując proces CVD i korzystając z ksylenu jako dodatkowego źródła węgla. Węgiel jest reduktorem, koniecznym do zastosowania w celu przeciwdziałania nadmiernemu rozrostowi nanoziaren Pd, które w wysokich temperaturach procesu CVD mogą ulegać zbytniej aglomeracji. Szybkość wkraplania ksylenu do reaktora kwarcowego wynosiła 0,1 ml/min. Proces prowadzono w warunkach ciśnienia atmosferycznego w przepływie argonu (40/h), stanowiącego nośnik dla par ksylenu. Aby zbadać wpływ temperatury procesu CVD na strukturę próbki, zwłaszcza na wielkość ziaren Pd oraz rodzaj matrycy węglowej stosowano temp. w zakresie od 500 do 750°C, zmieniając temp. co 50°C

POMIARY WŁAŚCIWOŚCI SENSOROWYCH

Pomiary właściwości sensorowych prowadzono na stanowisku pomiarowym w temp. pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym w obecności 1% $\rm H_2/N_2$ w stałym przepływie gazu 50 ml/min. Po każdym cyklu pomiarowym do komory stanowiska wprowadzano

powietrze w celu usunięcia wodoru z badanej próbki. Czułość warstw CVD definiowano jako procentowe zmiany w rezystancji [(ΔR)/R₂]*100%, gdzie $\Delta R=R_{H2}$ -R₀ a R_{H2} jest rezystancją warstwy w obecności H₂, R₀ jest rezystancja warstwy w powietrzu.

Czas odpowiedzi t₉₀, to czas po którym sygnał wejściowy osiąga 90% swojej wartości końcowej.

W pomiarach elektrycznych obserwowano wzrost rezystancji warstw, co świadczy o tworzeniu się wodorku palladu PdH_x w fazie β . Z literatury wiadomo, że rezystancja PdH_x jest większa od rezystancji czystego metalu Pd.

wiedź warstw na obecność 1% H₂ z procesów CVD modyfik wanych w temperaturze 500°C(a) i 550°C (b) oraz (c) odpowied ź



WNIOSKI

- Średnica i kształt ziaren Pd z warstw modyfikowanych w procesie CVD zależy od temp. procesu;
- W warstwach modyfikowanych w procesie CVD w temp. najniższych ~500 i 550°C znajdowano najdrobniejsze nanoziarna Pd ~7-10 nm;
- Średni rozmiar nanoziaren Pd wzrasta wraz ze wzrostem temp. procesu CVD. Ale w warstwach uzyskanych w zakresie temp. 600-750°C, wokół nanoziaren Pd obserwowano otoczki grafitowe;
- > We wszystkich próbkach z procesu CVD obserwowano wzrost rezystancji, co świadczy o tworzeniu się wodorku palladu PdH,
- > Warstwy zawierające nanoziarna Pd o najmniejszych rozmiarach charakteryzowały się najwiekszą czułością ~7-9%. Czas odpowiedzi $\rm t_{90}\,dla$ tych warstw wynosi 60-90 s;
- > W próbkach zawierających nanoziarna Pd w otoczkach grafitowych czułość warstw była znacząco niższa ~0.13 - 0.30%, co powodowało skrócenie czasu odpowiedzi 33-68 s. Sugerujemy, że otoczki grafitowe mogą być odpowiedzialne za pogorszenie się czułości tych warstw,
- Warstwy CVD reagują również na amoniak o stężeniu 100 ppm.

Praca jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (projekt pt. "Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych", umowa Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-08)

